



saclay

Imagerie CCD en astronomie

O. Boulade Service d'Astrophysique, CEA/DAPNIA

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007

1

Les CCDs en astronomie

- dapnia CCDs utilisés en astronomie depuis 1980
 - Détecteurs de choix pour les longueurs d'onde du visible aux X
 - Grands plans focaux possibles
- saclay



XMM-EPIC 0.3-10 keV



Canada-France-Hawaii Telescope Corporation & TERAPIX/IAP 2004

Courtesy of LSS Consortium, A. Read and ESA

Plan du cours

- dapnia 1er cours: généralités sur le détecteur CCD
 - Principes du CCD
 - Paramètres et performances
- saclay
 - 2ème cours: utilisation d'un détecteur CCD
 - Mesures des performances
 - Observations et traitement d'images
 - Développements récents
 - 3ème cours: quelques problématiques particulières
 - CCDs et spatial
 - Utilisation des CCDs en astronomie X
 - Grands plans focaux à base de CCDs



saclay

Introduction

Un CCD, à quoi ça ressemble?

dapnia • Détecteur à base de silicium

saclay

- Si dopé p ou n
- Une grille d'électrodes définissant des « pixels »
- Un (ou plusieurs) circuit(s) de lecture
- CCD astronomique standard: 2Kx4K pixels de 15x15µm, 30x60mm



© CEA-DAPNIA

Plan focal à base de CCDs

dapnia • Détecteurs « aboutables »

saclay

– Mosaïque de CCDs permettant d'obtenir quelques 10⁸ pixels



© CEA-DAPNIA/J.J Bigot

Références

- dapnia Détecteur CCD
 - Scientific Charge-Coupled Devices, J. Janesick, SPIE press, 2001
 - http://www.ing.iac.es/~smt/CCD_Primer/CCD_Primer.htm
 - http://www.astro.psu.edu/xray/docs/cal_report/cal_report.html
- saclay Forum de discussion CCD-world http://www.ctio.noao.edu/CCD-world/
 - Conférences Scientific Detectors Workshop 1996-2005, Kluwer/Springer
 - Caméras CCDs
 - http://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Imaging/MegaPrime/
 - Articles MegaCam: Boulade et al., Aune et al., Roussé et al., SPIE vol 4841, 2002; Borgeaud et al., SPIE 4008, 2000; de Kat et al., SDW, 2002
 - Traitement d'images
 - http://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Elixir/home.html
 - http://www.cfht.hawaii.edu/Science/CFHTLS-DATA/rawdata.html#P3
 - http://www.cfht.hawaii.edu/Science/CFHTLS-DATA/dataprocessing.html
 - http://terapix.iap.fr

Glossaire

- dapnia Back side illuminated CCD: CCD éclairé par l'arrière
 - Bias: image obtenue avec un temps de pose de 0 seconde
 - Blooming: débordement des charges d'un pixel à l'autre en cas de saturation
- saclay
- Bruit de lecture (readout noise): bruit de l'étage de sortie du CCD
 - Bruit de photons (shot noise): bruit lié à la statistique poissonnienne des photons
 - Capacité pixel (full well): quantité de charges qu'un pixel peut contenir
 - CCDs aboutables: CCDs qu'on peut mettre bout à bout pour former des mosaïques
 - CCD frame transfer (à transfert de trame): CCD dont la moitié de la surface est photosensible, l'autre moitié servant à stocker les images
 - CCD full frame: CCD dont toute la surface est photosensible
 - Channel stop: volume de Si avec un dopage particulier permettant de séparer les colonnes de pixels
 - Clocked anti-blooming: dispositif permettant d'éviter le blooming
 - Cosmétique: caractérisation du nombre de défauts (pixels, colonnes) d'un CCD

Glossaire

dapnia • Courant d'obscurité (dark current): signal généré par la création de paires électron-trou par effet thermique

- Cosmiques: impacts de particules du rayonnement cosmique
 - Dark: image obtenue en laissant le CCD dans l'obscurité
- saclay
- Effet photo-électrique: excitation d'un électron par un photon incident
 - Efficacité de transfert de charge (charge transfer efficiency): fraction des charges électriques transférées d'un pixel au précédent au cours de la lecture du CCD
 - Flat field: image obtenue en éclairant uniformément le CCD
 - Front side illuminated CCD: CCD éclairé par l'avant
 - Glitches: cosmiques
 - Multi pinned phase: mode d'utilisation du CCD permettant de réduire le courant d'obscurité à température élevée
 - Non uniformité pixel: dispersion de rendement quantique des pixels
 - Orthogonal transfer CCD: désigne un CCD où l'on peut transférer les charges aussi bien horizontalement que verticalement
 - Overscan pixels: pixels virtuels obtenus en continuant la lecture après avoir lu tous les pixels physiques

Glossaire

- dapnia Photon transfer curve: méthode de caractérisation d'un CCD
 - Pixel: brique élémentaire d'un détecteur matriciel
 - Point spread function: image donnée par une source ponctuelle
- Registre série: ligne de pixels permettant le transfert vers le circuit de lecture
 - Rendement quantique (quantum efficiency): rapport entre le nombre de photons détectés et le nombre de photons incidents
 - Superflat: flat field obtenu en combinant toutes les images d'une nuit dans un filtre donné
 - Time delayed integration: mode d'observation particulier où la lecture du CCD se fait à la même vitesse que le défilement du champ de vue
 - Zone de déplétion: volume du pixel dans lequel se passe la collecte des électrons créés par effet photo-électrique

Abréviations, acronymes et autres sigles

- dapnia ADC: analog-to digital converter
 - APS: active pixel sensor
 - CCD: charge coupled device (DTC, dispositif à transfert de charges)
 - CDS: correlated double sampling (double échantillonnage corrélé)
- saclay CEA: commissariat à l'énergie atomique
 - CFHT: Canada-France-Hawaii Telescope
 - CFHTLS: CFHT Legacy Survey
 - CMOS: complementary metal oxyde semiconductor
 - CNES: centre national d'études spatiales
 - CTE: charge transfer efficiency
 - DAPNIA: département d'astrophysique, de physique des particules, de physique nucléaire et d'instrumentation associée
 - DUNE: dark universe explorer
 - EMCCD: electron multiplying CCD
 - EPIC: European Photon Imaging Camera
 - ESA: agence spatiale européenne
 - LBNL: Lawrence Berkeley national laboratory

Abréviations, acronymes et autres sigles

- dapnia MIT: Massachussets institute of technology
 - MPP: multi pinned phase
 - OTA: orthogonal transfer array
 - OTCCD: orthogonal transfer CCD
- Pan-STARRS: panoramic survey telescope & rapid response system
 - Pixel: picture element
 - PRNU: pixel response non uniformity
 - PSF: point spread function
 - QE: quantum efficiency
 - SNAP: supernova acceleration probe
 - TDI: time delayed integration
 - XMM: X-ray Multi-Mirror satellite

Historique

- dapnia 1970 : principe du CCD (Boyle et Smith, Bell Labs)
 - 1974 : 1^{ère} image astronomique (CCD Fairchild 100x100)







- 1979 : CCD RCA 512x320 aminci (3.5'x2' sur le ciel)
- 1981 : 1ères caméras CCDs en France (B. Fort, L. Vigroux)
- 1990 : 1ers CCDs « grand format » 2Kx2K (7'x7')
- 1994 : 1ères caméras mosaïque
- 1999 : caméra CFH12K, 12 CCDs 2Kx4K, 12Kx8K pixels (42'x28')
- 2002 : caméra MegaCam, 40 CCDs 2Kx4.5K, 20Kx18K pixels (1°x1°)





saclay

Principes du CCD

Principes de fonctionnement du CCD

dapnia • CCD: charge coupled device (DTC: dispositif à transfert de charges)

- **·** 4 étapes
 - Détection des photons incidents
- saclay Génération de paires électron-trou par effet photo-électrique
 - Accumulation des charges
 - Capacité MOS (métal-oxyde-semiconducteur)
 - Transfert des charges vers circuit de lecture
 - Transfert de proche en proche
 - Lecture de l'information
 - Génération d'une tension au niveau du CCD puis transfert vers électronique externe et digitalisation
 - Le terme CCD se réfère au mode de lecture de l'information, non à la génération de cette information.

Détection des photons

saclay

- dapnia Effet photo-électrique dans un semiconducteur (Si)
 - Gap entre bande de valence et bande de conduction: 1.14 eV
 - Un photon incident d'énergie > 1.14 eV crée une paire e-/trou
 - Accumulation des charges: capacité MOS (métal-oxyde-semiconducteur)
 - Un substrat Si, un isolant SiO₂, une électrode
 - Si dopé « p »: porteurs majoritaires trous
 - Tension > 0: création zone vide de trous (zone de déplétion)
 - Les photo-électrons ne se recombineront pas
 - Accumulation des e- dans la zone de déplétion



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Collecte des photons

- dapnia CCD canal en surface (surface channel)
 - Pb: les e⁻ s'accumulent à l'interface Si-SiO₂
 - Mauvaises performances: pièges, faible transfert, ...
 - CCD canal enterré (buried channel)
 - Une couche de Si dopé n entre le SiO₂ et le Si dopé p
 - Analogue à une diode p-n
 - Les e⁻ s'accumulent en profondeur



Transfert des charges

dapnia • Plusieurs (3) électrodes par pixel

- Une électrode de collecte, et deux de barrière
- Transfert des charges de proche en proche
- Couplage des charges entre pixels





Organisation matricielle des pixels

- dapnia
 Le long d'une colonne, les paquets de charges sont séparés les uns des autres par les différents potentiels générés par les électrodes
 - Les colonnes de pixels sont séparées les unes des autres par un dopage p spécifique (« channel stop ») qui évite la diffusion des charges
- Une ligne supplémentaire de pixels, le registre série, est connectée au circuit de lecture





Lecture de l'information

- dapnia Transferts successifs du contenu des pixels
 - De la 1ère ligne dans le registre série
 - De chaque ligne dans la précédente
 - Du 1er pixel du registre série dans le circuit de lecture
 - De chaque pixel du registre série dans le précédent



© e2v technologies

- Génération d'une tension aux bornes de la capacité de lecture
- Envoi vers l'électronique externe: échantillonnage, digitalisation, transfert vers ordinateur d'acquisition, stockage

Séquence de lecture

- dapnia · Reset du niveau de sortie
 - Transfert du pixel dans le « summing well » et mesure du niveau reset
 - Transfert du « summing well » sur la capacité de lecture et mesure du niveau signal
 sw ØR RD OD

saclay



21

Architectures

- dapnia · CCD « full frame »
 - Toute la zone du CCD est photosensible, et on commence la lecture à la fin de la pose
 - Principale architecture utilisée en astronomie

- CCD « frame transfer »
 - Une moitié du CCD est masquée et à la fin de la pose, on transfère les charges de la zone photosensible dans la zone masquée
 - La lecture de la pose n se fait en même temps que la pose n+1
 - Parfois utilisé en astronomie (COROT)
- CCD « interline transfer »
 - Une colonne de pixels sur 2 est masquée, et on transfère chaque colonne photosensible dans la colonne masquée lui correspondant
 - Utilisation en cadence video (télévision)





saclay

Paramètres et performances

Paramètres d'un CCD

dapnia • Détection des photons

- Rendement quantique (quantum efficiency QE)
- Collection des charges
 - Nombre de pixels
 - Capacité du pixel (full well)
 - Non uniformité pixel (pixel response non uniformity PRNU)
 - Diffusion
 - Courant d'obscurité (dark current)
 - Cosmétique
 - Transfert de charges
 - Efficacité de transfert (charge transfer efficiency CTE)
 - Lecture de l'information
 - Linéarité
 - Bruit de lecture (readout noise RN)
 - Rapport signal à bruit

Rendement quantique (QE)

- dapnia Mesure de l'efficacité de conversion photon électron
 - Un photon d'énergie < gap Si (1.14 eV) ne peut pas créer de paire électron-trou
 - QE = 0% pour une longueur d'onde > 1.1 μ m
 - Pour observer en IR, il faut utiliser un autre semiconducteur, ex Ge (gap 0.66 eV, longueur d'onde < 1.6 μm), mais mauvaises performances
 - Un photon d'énergie comprise entre 1.14 et 3.1 eV crée une paire électron-trou: domaine visible (4000 - 11000 Å)
 - Un photon d'énergie > 3.1 eV crée plusieurs paires électron-trou: un photon X d'énergie 5.9 keV (longueur d'onde 2.1 Å) génère 1620 e-
 - Au delà de 10 keV, la probabilité d'interaction d'un photon avec un électron est trop faible: pas de détection

Dépendance en longueur d'onde du QE

- dapnia La profondeur de pénétration du photon dépend de son énergie
 - Pour un photon « bleu » (400 nm): ~0.2 μ m
 - Pour un photon « rouge » (800 nm): ~10.5 μm
- Pb: si l'e⁻ est créé dans une zone trop éloignée du champ électrique, il se recombinera hv

150-500 μ m \int \int \int \int \int \int \int \int \int hv

- CCD épais et éclairé par l'avant: rendement quantique très faible dans le bleu, moyen dans le rouge (QE max ~50%)
- Pour avoir un bon QE dans le bleu, il faut un CCD aminci et éclairé par l'arrière (QE > 80%), mais faible rendement dans le rouge
- CCD aminci très délicat à fabriquer: beaucoup plus cher

CCD épais vs CCD aminci



Traitement AR

- dapnia Indice de réfraction du Si: 3.6
 - Coefficient de réflexion = $(1-n_{Si})^2/(1+n_{Si})^2 = 0.32$
 - Un CCD éclairé par l'arrière nécessite un traitement anti-reflet pour maximiser le QE



CCD « deep depletion »

- dapnia CCD aminci éclairé par l'arrière
 - Epaisseur substrat augmentée pour détecter dans le rouge: 40 µm
 - Zone de déplétion augmentée pour détecter dans le bleu: Si haute résistivité (~10 kΩ-cm)



Dépendance en température du QE

- dapnia Plusieurs paramètres dépendent de la température
 - Energie de gap du Si

saclay

- Profondeur d'absorption des photons
- Champ électrique dans le Si
- Taux de recombinaison des e-
- Le QE augmente avec la température: ~7 10⁻⁴ par degré



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Evolution de la taille des CCDs

- dapnia 1er CCD astronomique: Fairchild 100x100
 - 1979: CCD RCA 512x320, pixels 30µmx30µm
 - 1990: premiers CCDs 2Kx2K
 - Le standard astronomique est un CCD 2Kx4K, pixels de 15µmx15µm
- Saclay
 Les CCDs géants (4Kx4K à 9Kx9K) commencent à être utilisés en astronomie mais:
 - Temps de lecture longs
 - Taille des wafers limitée donc petits pixels, peu efficaces
 - Grand nombre de transferts
 - Rendement de fabrication faible, donc coût élevé



e2v 4Kx4K 12µmx12µm



Fairchild 4Kx4K 15µmx15µm



Fairchild 9Kx9K 8.75µmx8.75µm

Capacité pixel (full well)

dapnia • Nombre maximum de charges qu'un pixel peut contenir

 Dans un CCD actuel avec un pixel de 15µmx15µm, on atteint une capacité ~200-250 ke⁻

Détermine la dynamique possible du CCD (rapport entre les signaux saclay min et max détectables)

- Quand le pixel est plein, il y a saturation (blooming): les charges débordent sur les pixels adjacents le long de la colonne
- La technique du « clocked anti blooming » permet de limiter cet effet



Non uniformité pixel (PRNU)

- dapnia Variation de sensibilité de pixel à pixel
 - Origine liée au process: précision de la lithographie, amincissement,
 - franges d'interférence dues à des réflexions internes, ...
 - Non uniformité dépendante de la longueur d'onde
- Niveau typique: 1-2%, corrigeable par la technique du champ plat (flat field): on illumine la surface du CCD avec une source uniforme







Diffusion des charges

dapnia • Les e- qui « voient » le champ électrique s'accumulent à la jonction p-n

ന്ന

• Ceux qui sont générés trop loin (à la frontière de 2 pixels, trop loin dans le substrat, sous les channel stops, …) diffusent et peuvent être collectés dans différents pixels: dégradation de la résolution spatiale



- En pratique: CCD e2V 4280, pixels de 13.5 μm , taille effective 16 μm
- Problème potentiel pour les CCDs très épais (~300 µm)

Courant d'obscurité (dark current)

- dapnia Charges parasites créées par agitation thermique
 - Pour diminuer le niveau de courant d'obscurité, il faut refroidir le CCD
 - CCD e2V aminci: Qd/Qd₀=122T³e^{-6400/T}, Qd₀ dark à l'ambiante
 - A 150-160K, courant de l'ordre de quelques e-/pixel/heure



• Mode « multi-pinned phase » (MPP): permet de réduire le courant d'obscurité à haute température (-40°C) d'un facteur ~100 (élimine le courant d'obscurité généré à l'interface Si-SiO₂)

Le mode MPP diminue aussi le full well d'environ 1/3

Cosmétique

saclay

dapnia • Proportion de pixels défectueux (« hot » pixels, « white » pixels)

- Courant d'obscurité très élevé généré par des défauts locaux d'un pixel
- Le principe du CCD fait qu'un pixel chaud génère une colonne chaude
 - En particulier, le registre série ne doit comporter aucun pixel défectueux
- La qualité cosmétique limite le rendement de fabrication et la taille des CCDs, et détermine le prix!
- Cosmétique fortement dépendante de la température
- CCDs MegaCam (e2V 4290): 0.1% de colonnes chaudes à 153K



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure
Efficacité de transfert de charges (CTE)

dapnia • Fraction des charges transférées d'un pixel au précédent pendant la lecture

• Pour n transferts, $S_{out} = CTE^n x S_{in}$

saclay

- Paramètre fondamental qui détermine la qualité des images:
 - Avec une CTE de 99.99%, il n'y a plus que 90% du signal dans un pixel après 1000 transferts, et 67% du signal après 4000 transferts

• La CTE dépend de nombreux paramètres: température, vitesse de transfert, quantité de charges à transférer, ...

• La CTE est dégradée par la présence de pièges (dus au design, à la fabrication ou aux radiations), qui relâchent les charges après un certain délai:

- CCD à canal en surface: CTE ~0.99 (après 100 transferts, il reste 36.6% du signal)
- CCD à canal enterré actuel: CTE ~0.999999 (après 4000 transferts, il reste 99.6% du signal)

Dégradation de la qualité image par la CTE



38

Linéarité

- dapnia
 La génération, la collecte et le transfert des charges sont linéaires par construction
 - La conversion charges-tension du circuit de sortie est linéaire sauf à très bas signal



 Typiquement un CCD est linéaire sur une très grande plage: 100 -200ke⁻, avec une non linéarité <1%

Bruit de lecture

- dapnia Bruit blanc de l'amplificateur du circuit de sortie
 - Dépend de la vitesse de lecture
- œ

TYPICAL OUTPUT CIRCUIT NOISE

(Measured using clamp and sample, temperature range 140 - 230 K)

saclay



• Il faut trouver un compromis entre la vitesse de lecture (et le temps de télescope perdu) et le niveau de bruit

• Typiquement, bruit ~4-5 e-

Double échantillonnage corrélé

- dapnia Il faut une capacité très petite pour une bonne sensibilité: V = Q/C
 - Le bruit associé au niveau de reset est un bruit blanc (bruit « kTC »):

$$N(V) = \sqrt{kT/C}$$
 ou $N(e) = \sqrt{ktC}/q$

- Pour C=40fF, on a $S_V=4\mu V/e^-$ et N=57e⁻: bruit beaucoup trop élevé!
- On supprime ce bruit en mesurant à la fois le niveau référence et le niveau pixel: double échantillonnage corrélé (« CDS »)
 - « Clamp and sample », « Dual slope integrator »
 - CDS digital (Gach et al., PASP 115, 1068, 2003): niveaux échantillonnés 100 à 200 fois, puis traitement digital du signal: nécessite des ADC rapides (≥10MHz)



saclay

« On-chip binning »

dapnia • On peut additionner le contenu de plusieurs pixels avant la lecture

- Transfert de la 1ère ligne de la zone image dans le registre série
- Transfert de la 2ème ligne de la zone image dans le registre série
- saclay
- \Rightarrow Addition des contenus des 2 premières lignes
 - Transfert du 1er pixel du registre série dans le summing well
 - Transfert du 2ème pixel du registre série dans le summing well
 - \Rightarrow Addition du contenu des pixels (1,1), (2,1), (1,2) et (2,2)
 - Transfert du summing well dans le circuit de lecture
- Augmentation du rapport signal à bruit
- Augmentation de la vitesse de lecture
- Baisse de la résolution spatiale
- On peut transformer un CCD 4Kx4K avec pixels de 12µmx12µm en un CCD 2Kx2K avec pixels de 24µmx24µm…

Température optimale de fonctionnement

Certaines performances varient avec la température dapnia Il existe une plage de températures optimales vers 150-170K Dark current White columns 4030 30 Δ saclay Dark current (e-/hr) ≙ Number Number 20 Δ Δ 10 10 Δ Δ 0 0 120 140 180 200 120 140 180 200 160 160 Temperature (K) Temperature (K) Serial CTE QE at 173K - QE at 153K 1.00000 4 0.99999 Difference (%) ED 0.99998 2F 0.99997 0.99996 0.99995 0 140 200 180 400 1000 120 160 600 800 Temperature (K) Wavelength (nm)

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Sources de bruit

- dapnia Bruit de photons (shot noise)
 - Statistique de Poisson: $N_{ph} = \sqrt{S_{ph}} = \sqrt{S_{sc} + S_{bg}}$
 - Bruit du courant d'obscurité
 - Même statistique que les photons: $N_{dc} = \sqrt{S_{dc}}$
- Bruit de non uniformité de réponse des pixels
 - Proportionnel au signal: $N_{ff} = ff \times S_{ph} = ff \times (S_{sc} + S_{bg})$
 - Bruit de lecture
 - Constant: $N_{rn} = RN$
 - Bruit total = somme quadratique des différentes sources de bruit
 - Bruit total:

$$N_{tot} = \sqrt{S_{sc} + S_{bg} + S_{dc} + ff^2} \times (S_{sc} + S_{bg})^2 + n_{pix} \times RN^2$$

- Rapport signal à bruit:

$$SNR = S_{sc} / \sqrt{S_{sc} + S_{bg} + S_{dc} + ff^2 \times (S_{sc} + S_{bg})^2 + n_{pix} \times RN^2}$$

Rapport signal à bruit

- dapnia 3 régimes de fonctionnement
 - A très bas signal, SNR dominé par le bruit de lecture: $N_{tot} \approx cte$
 - Puis par le bruit de photons: $N_{tot} \approx \sqrt{S_{sc} + S_{bg} + S_{dc}} \propto \sqrt{t_{pos}}$
 - Puis par la PRNU: $N_{tot} \approx ff \times (S_{sc} + S_{bg}) \propto t_{pos} \implies SNR \text{ constant!}$
- La courbe bruit vs signal est appelée « photon transfer curve »



Temps de pose et rapport signal à bruit

- dapnia · En pratique
 - Courant d'obscurité négligeable: S_{dc}~5-10 e⁻/heure/pixel
 - Bruit de lecture: RN ~4-5 e⁻
 - PRNU: ~1-2 %
- saclay
- Fond de ciel dans le visible: de quelques e⁻/s/pixel au sol (CFHT/MegaCam) à quelques 1/100 e⁻/s/pixel (HST/ACS)

• Au sol, chaque pose dure le temps juste nécessaire pour travailler dans un régime dominé par le bruit de photons: 5-20 minutes par pose, en fonction du domaine de longueur d'onde et de la largeur du filtre

• Dans l'espace, on arrive rarement à ce régime, et le bruit de lecture peut contribuer significativement au bruit total





saclay

Mesures des performances

Banc de caractérisation des CCDs

- dapnia Dark + cosmétique
 - Linéarité +full well
 - QE + PRNU
 - Gain

• CTE

- saclay
- RN



CEA-DAPNIA

Mesure du bruit de lecture

• On fait une série de bias (lecture immédiate du CCD à temps de pose
 • Os), et la dispersion des valeurs des pixels donne le bruit de lecture

• On peut mesurer le niveau de bias (zéro de l'électronique) et le bruit de lecture sur chaque image scientifique en continuant la lecture après avoir lu tous les pixels physiques (« overscan pixels »)



Mesure du courant d'obscurité et cosmétique

- dapnia 2 possibilités:
 - Poses courtes à température élevée et extrapolation en utilisant un
 - modèle de dépendance en température
 - On gagne du temps mais mesures non précises (e2v)
- saclay Poses longues (1 heure) à basse température
 - Permet de détecter des effets à faible niveau





Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Mesure de la CTE

saclay

dapnia • Plusieurs méthodes, la plus fiable est d'utiliser une source de Fe⁵⁵

- Emission de photons X à 5.9 keV: 1620 e⁻ par photon
- On illumine uniformément le CCD et on mesure la différence de signal dans une zone proche du circuit de sortie et dans les zones les plus éloignées
 - Permet également la mesure du gain de l'électronique (e⁻/ADU)



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Mesure de la linéarité

saclay

dapnia
 Très simple: on mesure le signal donné par une source lumineuse stable, et on augmente le temps de pose, déterminé par un obturateur, pour explorer toute la dynamique

 On peut aussi travailler à temps de pose constant et augmenter le flux de la source

• MegaCam: matrice de LEDs rouges pulsées



Mesure du QE

- dapnia
 Rapport entre le flux émis mesuré par la photo-diode et le flux observé mesuré par le CCD
 - Source de lumière monochromatique
 - Photo-diode calibrée
- saclay Sphère intégratrice







saclay

Observations et traitement d'images

Observations en mode pointé

- dapnia Le télescope est pointé sur la zone à observer, et reste fixe par rapport à cette zone
 - CCD full frame
 - CCD standard: toute la surface est photo-sensible
- saclay
- Un obturateur s'ouvre et se ferme pour définir le temps de pose, puis lecture de l'image, et nouvelle pose
- Pour: simple et naturel
- Contre: efficacité d'observation non optimale
- CCD frame transfer
 - CCD dont la moitié de la surface est masquée pour ne pas être photo-sensible
 - On fait une pose, puis on transfère très rapidement le contenu de la zone photo-sensible dans l'autre moitié du CCD, puis on lit tranquillement cette moitié pendant la pose suivante
 - Pour: pas besoin d'obturateur, pas de temps de télescope perdu pendant la lecture du CCD
 - Contre: champ de vue 2 fois plus petit

55

Observations en mode TDI (time delayed integration)

- On laisse défiler le ciel devant le télescope, avec un mouvement parallèle aux colonnes du CCD
 - Le CCD est en lecture permanente, avec une vitesse de transfert des lignes égale à la vitesse de défilement du ciel
- saclay
- Les e⁻ générés par les photons issus de la source restent dans le même paquet de charges
 - Le temps de pose est égal au temps de traversée d'un CCD
- Pour: pas besoin d'obturateur, pas de temps de télescope perdu pendant la lecture du CCD, très peu de manœuvres du télescope

• Contre: il faut asservir le mouvement du télescope sur l'électronique de contrôle du CCD, et il faut assurer un mouvement du télescope parallèle aux colonnes du CCD

 Mode d'observation peu utilisé en astronomie (SDSS, Gaia, DUNE) mais beaucoup utilisé en observation de la Terre, et très bien adapté à de très grands surveys

Images et calibrations nécessaires

- N images d'un même champ, en dépointant légèrement le télescope (mode pointé) ou en décalant les CCDs (mode TDI)
 - Elimination des impacts du rayonnement cosmique
 - Minimisation des effets des pixels défectueux
- saclay Bias: poses à temps de pose 0s
 - Soustraction du niveau zéro donné par l'électronique
 - Dark: poses à l'obscurité de durées égales aux poses scientifiques
 - Soustraction du courant d'obscurité
 - Flat fields et superflats: cartes de PRNU à travers les filtres utilisés pour les poses scientifiques
 - Correction de la dispersion de QE des pixels
 - Standards photométriques: mesures d'étoiles de magnitudes connues
 - Conversion du signal mesuré en unités physiques
 - Standards astrométriques: mesures d'étoiles de positions connues
 - Conversion coordonnées pixel (x,y) en coordonnées ciel (α , δ)
 - Correction de la distorsion optique

Correction du bias

- dapnia A priori même niveau pour tous les pixels
 - Soustraction pixel à pixel nécessaire pour corriger d'éventuels défauts



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Correction du dark

 dapnia
 Soustraction pixel par pixel car les images de courant d'obscurité peuvent avoir de la structure



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Correction du flat field et des franges



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007

60

Preprocessing

dapnia
 Les opérations précédentes constituent le « preprocessing » des données, c'est-à-dire la correction des effets instrumentaux



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Calibration photométrique

dapnia • Observations de champs spécifiques d'étoiles de luminosités connues

- Calcul du signal mesuré sur chacune de ces étoiles
- Transformation des flux instruments (ADUs) en flux de photons (mag)
- Précision photométrique sur données CFHTLS ~ 0.004mag (0.4%) saclay



62

Calibration astrométrique

- dapnia Extraction dans chaque image d'une liste d'objets brillants
 - Comparaison avec un catalogue d'étoiles de coordonnées connues
 - Transformation des coordonnées pixels (x,y) en coordonnées ciel (α , δ)
- Précision astrométrique sur données CFHTLS ~ 20mas (1/10 pixel)



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007

Coaddition et Cataloguage

- Une fois les N images d'un même champ « astrométrées », on peut les coadditionner pour obtenir la sensibilité voulue
 - Enfin on extrait toutes les sources contenues dans les images (logiciel Sextractor, Bertin et Arnouts, A&A 117, 393, 1996)
- saclay
- Calcul de position, magnitudes, formes, …
 - Génération de catalogues d'objets



Bertin, Gretsi 2005, pp299-302

Exemple de traitement d'un champ



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007



saclay

Développements récents

Récapitulatif des CCDs actuels

- dapnia Détecteurs quasi parfaits!
 - QE élevé
 - Linéaire

saclay

- Grande dynamique
- Faible bruit
- Grande taille

D [*] tecteur	Plaque photo Kodak	Kodak 5 Mpixels	e2v 42-90
Nombre pixels		2600x1970	2048x4608
Taille pixels (µm)	4x4	6.8x6.8	13.5x13.5
Taille d [*] tecteur (mm)	350x350	18x13	28x62xMxN
QE (BGR)	0.02 0.03	0.32 0.40 0.32	0.85 0.80 0.75
Lin arit (%)	Non (log)	16	0.5
Full well (ke⁻)		30	250
PRNU (%)		15	2
Dark (e ⁻ /s)		200	0.003
Colonnes chaudes		0	2
CTE		0.999995	0.999995
Bruit (e ⁻)		30	5
Data rate (MHz)		25	0.166
Prix (Ū)	100 par plaque	< 900	22 k

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

CCDs « fully depleted »

saclay

- dapnia
 Même idée que les CCD à deep depletion mais sur une plus grande épaisseur pour avoir un grand QE dans le rouge et le bleu
 - Développement au LBNL dans le cadre du projet SNAP
 - CCD épais (100 300 µm), Si dopé n avec canal enterré p
 - Résistivité 10 k Ω -cm au lieu de 20 40 Ω -cm
 - Tension de substrat 20 70 V au lieu de 10 V
 - Développement similaire chez e2v



CCDs « Low light level (L3) »

dapnia • EMCCDs: electron multiplying CCDs

saclay

- Problème: la turbulence atmosphérique varie à l'échelle de quelques dizaines de milli-secondes, et défléchit les rayons lumineux
 - ⇒ Une image résultant d'une pose de plusieurs secondes est donc dégradée par rapport à la limite théorique (diffraction)
 - But: on veut augmenter la qualité image en réduisant l'effet de la turbulence atmosphérique (alternative à envoyer un télescope dans l'espace)
 - \Rightarrow II faut donc faire des poses ultra-courtes et lire le CCD à cadence très élevée (quelques MHz)
 - \Rightarrow Or le bruit de lecture augmente très vite avec la cadence: 4-5 evers 100 kHz, quelques dizaines d'e- vers 10 MHz
 - Solution: un registre de gain entre le registre série et le circuit de lecture
 - C'est un registre série où une des tensions appliquées pour le transfert des charges est très élevée (40-50 V au lieu de 10 V) pour accélérer les e- et déclencher un phénomène d'avalanche
 - Le signal multiplié est ensuite converti par un circuit de lecture standard

CCDs « Low light level (L3) »

- dapnia Collaboration e2v université Cambridge
 - CCD e2v 97-00: 512x512 pixels plus un registre gain de 536 éléments
 - Multiplication du signal: x250 x3000
 ⇒ Cadence lecture 11 MHz

saclay

- Haute résolution spatiale
- Comptage de photons



Fig. 5. A 1% selected image of ζ Boötis with a Strehl ratio of 0.26 and a FWHM of ~0.1", taken in 0.42" seeing.

Law et al., A&A 446, 739, 2006





CCD201 1Kx1K, © e2v technologies 2005

OTCCDs

- dapnia
 CCDs à transfert orthogonal, i.e. dans les 2 directions lignes et colonnes
 - Les channel stops sont remplacés par une 4ème électrode permettant de transférer horizontalement les charges

saclay





- Channel stop
- Les petits OTCCDs (512x512) sont assemblés en mosaïque de 8x8 (OTA)



OTCCDs

- Les étoiles brillantes servent à décaler les charges en temps réel et corriger du « tip-tilt » (mouvements du télescope générés par le vent)
 - Projet Pan-STARRS Lincoln Lab MIT université Hawaii



Normal guiding (0.73")



OT tracking (0.50")



Tonry et al., SDW 2002
APS/CMOS

- dapnia
 La principale limitation d'un CCD tient à son principe: la lecture par transfert des charges de proche en proche
 - Génération de colonnes chaudes à cause de pixels ayant un fort courant d'obscurité

- Dégradation de la qualité image à cause d'une plus ou moins bonne efficacité de transfert
- Pour y remédier on a développé les APS (active pixel sensor) ou CMOS (complementary metal oxyde semiconductor)
 - Chaque pixel contient sa propre électronique de lecture
 - Plus de problèmes de transfert
 - Possibilités d'adresser chaque pixel individuellement



Litwiller, Photonics Spectra, 2005

APS monolithiques

dapnia • Technologie récente

- Difficultés dans l'amincissement
- Faible QE (la partie active n'est pas photosensible)
- Pas de CMOS sur substrat haute résistivité
- Circuits de lecture plus bruyants que pour les CCDs
- L'idée de départ était d'utiliser les technologies CMOS en cours chez les fabricants de composants électroniques pour réduire les coûts
- Or un APS performant coûte aussi cher à développer qu'un CCD
 - \Rightarrow Peu utilisés pour l'instant en astronomie
 - \Rightarrow Pointage et guidage des satellites (« star trackers »)
- Développements en cours au CNES et à l'ESA

CMOS hybrides

dapnia
 Hybridation d'un plan de détection en Si type CCD avec un plan de lecture CMOS

 A priori on a les avantages des CCDs et des APS sans les inconvénients

saclay – Rockwell « Hyvisi » 2Kx2K en cours d'évaluation



Dorn et al., SPIE vol 6276, 2006

CMOS hybrides

saclay

- dapnia Nouveaux problèmes: diaphonie et rémanence
 - Diaphonie Hyvisi: 42% dont 8 à 10% dans chacun des 4 pixels les plus proches



Dorn et al., SPIE vol 6276, 2006

- Rémanence Hyvisi: très importante avec des objets surexposés



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure





saclay

CCDs et spatial

Pourquoi observer dans le spatial?

dapnia • L'atmosphère terrestre limite les observations

saclay

- Qualité image dégradée par la turbulence atmosphérique
- PSF 0.5" 1.0" au sol, 0.1" dans l'espace: HST



SUBARU

HST

- L'atmosphère terrestre absorbe la majeure partie du rayonnement électromagnétique
 - γ, X, UV, IR, sub-mm: Integral, XMM, IUE, ISO, Herschel

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Environnement spatial et CCDs

dapnia • Environnement beaucoup plus contraignant qu'au sol

- Tenue aux radiations
- Tenue aux vibrations
- Fiabilité

- Budgets (masse, volume, puissance électrique, ...) limités
- Fond de ciel plus faible
 - \Rightarrow Très peu de flux
- Niveau de radiations élevé
 - Dépôt d'énergie dans le détecteur
 - Création de paires e-trou
 - Déplacement des atomes dans la structure du silicium
 - \Rightarrow Pollution des images par les impacts de particules
 - \Rightarrow Vieillissement accéléré des détecteurs

Fonds de ciel

dapnia · Au sol

- CFHT/MegaCam
- Miroir 3.6m + pixels 0.19"
 - $\sim 10 \text{ e}$ -/s/pixel dans la bande i'

saclay

- Dans l'espace
 - HST/ACS/WFC
 - Miroir 2.4m + pixels 0.05"
 - $\sim 0.03 0.1 \text{ e}$ /s/pixel dans la bande i'
 - Quelques dizaines d'e- au plus à la fin de la pose
 - \Rightarrow Problèmes de non linéarité, efficacité de transfert, pièges

80

Rayonnement cosmique et images

- dapnia Ionisation du silicium par les protons et ions lourds
 - Fonction de l'orbite, de l'énergie des particules, de la géométrie des pixels
 - Très gênant avec des détecteurs épais, moins avec des CCDs amincis
- Les « cosmiques » ou « glitches » sont transitoires et s'éliminent par comparaison d'images successives (« deglitching »)
 - \Rightarrow Blindage des détecteurs
 - \Rightarrow Limitation du temps de pose



NASA HST/ACS



ESA ISO/ISOCAM

Courant d'obscurité et pixels chauds

- dapnia Déplacement des atomes dans la structure du silicium
 - Augmentation du courant d'obscurité et du nombre de pixels chauds

saclay



From left to right: before launch, and after 1, 2 and 3 years on orbit.

Pavlovsky, C. et al., Advanced Camera for Surveys Instrument Handbook for Cycle 16, STScI 2006.

Récupération des pixels chauds

- dapnia
 Technique de l'« annealing »: on chauffe les CCDs à intervalle régulier pour permettre à la structure cristalline de se remettre en place
 - Caméra WFC de l'instrument ACS du Hubble Space Telescope: un recuit par mois à +19°C pendant 6h
- saclay
- Permet de récupérer ~60% des pixels chauds



Pavlovsky, C. et al., Advanced Camera for Surveys Instrument Handbook for Cycle 16, STScI 2006.

Dose cumulée et dégradation du CCD

- dapnia Déplacement des atomes dans la structure du silicium
 - La dose cumulée augmente le nombre de pièges
 - Les charges sont piégées et relâchées après un certain délai
 - \Rightarrow Dégradation de la CTE

saclay

ACS/WFC parallel EPER vs. log (signal level in electrons), Max Mutchler, 13 Jan 2005



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007

84

Comparaison CCD sol - espace

dapnia · MegaCam

- e2v 42-90 2048x4608 13.5µmx13.5µm
- CCD aminci grand format 3 phases: produit standard
- Sur catalogue
- 22 k€ pièce (2,30k€ le Mpixel)
- DUNE
 - e2v 91-72 3330x4370 13.5µmx13.5µm
 - Développement spécifique par le fabricant (e2v) pour GAIA
 - 4 phases (pour le mode TDI)
 - Injection de charges (pour remplir les pièges)
 - Drains à différentes hauteurs le long du CCD (pour moduler le temps de pose)
 - Canaux enterrés spécifiques (« notch » et « super notch », permettant de réduire les effets des radiations, en particulier pour les petites quantités de charges)
 - 220 k€ pièce (15,10k€ le Mpixel)





saclay

Utilisation des CCDs en astronomie X

CCDs et photons X

- dapnia
 Les photons X « mous » ont une longueur d'absorption dans le Si comparable à celle des photons visibles
 - Un CCD ne détecte pas en UV (1000-2500Å) car la longueur d'absorption est trop petite
- Même problématique que dans le visible: il faut adapter la profondeur de la zone déplétée à la longueur d'absorption des photons



Fonction de redistribution

• Un photon X expulse un électron d'une couche profonde de l'atome
 Si. Cet électron ionise les atomes voisins, et l'atome Si se désexcite par fluorescence ou émission Auger

saclay

• Une source de Fe⁵⁵ (photons à 5.9 et 6.5keV) génère au moins 5 raies: Mn K α (5.9keV) et K β (6.5keV), pics d'échappement Mn K α (4.1keV) et K β (4.7keV), et fluorescence Si (1.7keV). La fraction de signal en dehors des raies Mn K α et K β est de quelques %



X-ray CCD Spectral Response Function Components

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

QE des CCDs X

saclay

- dapnia On obtient des QE très élevés avec des CCDs très épais:
 - CCD PN XMM/EPIC 300µm fully depleted BI
 - La calibration nécessite l'accès à un synchrotron
 - LURE (SACO et DCI), Orsay et BESSY, Berlin pour la caméra EPIC



89

Observations en X

 dapnia
 Les flux sont très faibles (~1 photon/pixel/min pour un amas de galaxies observé avec XMM): on peut travailler en comptage de photon

- Dans le visible on mesure le flux de photons, en X on mesure directement l'énergie de chaque photon
- Pour obtenir suffisamment de sensibilité, on coadditionne des milliers d'images (poses 10 à 20ks), très polluées par les impacts de cosmiques







Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007





saclay

Grands plans focaux à base de CCDs

Imagerie grand champ

dapnia · Constat

- Temps de télescope fini et rare
- Temps de télescope = temps de pose moyen x nombre de poses
 - ⇒Si on veut observer des objets très faibles, le temps de pose est long donc on ne peut pas faire beaucoup d'images et couvrir une grande surface du ciel
 - ⇒Si on veut couvrir une grande surface du ciel, il faut beaucoup d'images et on ne peut pas observer d'objets très faibles
 - ⇒Pour couvrir un grand champ et y observer des objets faibles, il faut un grand détecteur
- Une solution consiste en la fabrication de mosaïques de CCDs, avec plusieurs dizaines (voire centaines) de détecteur dans un même plan focal

Evolution des caméras CCDs à l'observatoire CFHT

dapnia CCC saclay	RCA1 1981-1986 1 CCD, 320x512 champ 2'x3.5'		5	RCA2 1986-1995 1 CCD, 640x1024 champ 2'x3.5'			 SAI 1 CC cham	IC1 19 D, 1K p 4.2'	90 x1K Lick2 1992 x4.2' 1 CCD, 2Kx2K champ 7'x7'			MOCAM 1994 4 CCDs, 4Kx4K champ 14'x14'				
										8 C	UH8K 1996 CDs, 8Kx8K 1amp 28'x28'					
			4	Mega 0 CCI cha	aCam Ds, 20 mp 1°	2002 Kx18k x1°	<		CF 12 C cha] FH12K 1999 CDs, 12Kx8F amp 42'x28'						

La caméra MegaCam

- dapnia Développée au CEA/DAPNIA
 - Installée au foyer primaire du télescope de 3.60m Canada-France-
 - Hawaii depuis Décembre 2002
 - Plan focal de 40 CCDs e2v 42-90 2Kx4.5K
- Saclay
 Champ de vue de 1°x1°



© CEA-DAPNIA/J.J Bigot

Cohabitation des détecteurs

dapnia
 Tous les points du champ de vue doivent être imagés avec la même sensibilité

œ

 \longrightarrow Performances identiques pour tous les détecteurs: à prendre en saclay compte dans le cahier des charges

 MegaCam: spécification de dispersion des 40 CCDs de 10% sur chaque paramètre

⇒Une fois intégrés dans le plan focal, tous les détecteurs doivent avoir le même point de fonctionnement

- Tous les pixels au foyer du télescope: contraintes sur la planéité de la mosaïque
- Tous les détecteurs doivent être à la même température: contraintes d'homogénéité spatiale et de stabilité temporelle de la température plan focal

Planéité de la mosaïque CCD

• Obtenue par « design »: spécification sur l'épaisseur des boîtiers dapnia CCDs et sur la planéité de la plaque support des CCDs

saclay



Thickness specification 14.000 ± 0.015

20

CCD CEA number

30







Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

10

14.020

14.010

14.000

13.990

13.980

0

Value (mm)

13-21 Juin 2007

96

150

Homogénéité et stabilité de température

Choix du matériau (Cu, Al, SiC, AlN, Be, Invar, ...) et modélisation thermique pour obtenir un gradient maximum de 3K sur toute la surface de la mosaïque

 Réseau de chaufferettes pour réguler la température en fonction des variations de l'environnement (température extérieure, orientation du télescope)



Le contrôleur CCD MegaCam: carte de pilotage

- dapnia 26 bias et horloges par détecteur, 40 détecteurs
 - 1 carte pour piloter 1 rangée de détecteurs (de 9 à 11 CCDs)

œ

saclay

PGA			
PIN	REF	DESCRIPTION	
A1, A8, C1, C8, F2, F7	V _{SS}	Substrate	
D8	IØ1	Image area clock, phase 1	Ť
E8	IØ2	Image area clock, phase 2	
F8	IØ3	Image area clock, phase 3	
D4	RØ1(L)	Register clock phase 1 (left)	
E4	RØ2(L)	Register clock phase 2 (left)	
D5	RØ1(R)	Register clock phase 1 (righ	
E5	RØ2(R)	Register clock phase 2 (righ	to block of the
F6	RØ3	Register clock phase 3	a na mana ka
E3	ØR(L)	Reset gate (left)	
E6	ØR(R)	Reset gate (right)	/
E2	ØSW(L)	Summing well gate (left)	
E7	ØSW(R)	Summing well gate (right)	
F3	DG	Dump gate (see note 8)	
D3	OG1(L)	Output gate 1 (left)	
D6	OG1(R)	Output gate 1 (right)	
B2	DD(L)	Dump drain (left)	
B7	DD(R)	Dump drain (right)	fert tert linds Sudt Sudt Linds Linds Just Just halt halt
D2	OG2(L)	Output gate 2 (left) (see not	AND 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00
D7	OG2(R)	Output gate 2 (right) (see n	<u>RER ARER ARER AREA AREA AREA AREA AREA </u>
B1	OD(L)	Output drain (left)	
B8	OD(R)	Output drain (right)	The second descence in the second
A2	OS(L)	Output source (left)	
A7	OS(R)	Output source (right)	
C2	RD(L)	Reset drain (left)	
C7	RD(R)	Reset drain (right)	

© e2v technologies 2004

CEA-DAPNIA

Le contrôleur CCD MegaCam: carte de lecture

- dapnia
 Spécifications: 30 secondes pour lire toute la mosaïque avec moins de 10 e⁻ de bruit
 - Solution: 30 secondes pour lire un demi-CCD et 80 chaînes d'acquisition fonctionnant en parallèle
- saclay 1 carte pour lire 1 rangée de détecteurs (de 18 à 22 sorties)



CEA-DAPNIA

Le contrôleur CCD MegaCam

- dapnia
 2 cartes pilotage, 2 cartes lecture et 1 carte DSP pour contrôler une demi-mosaïque
 - Faut-il passer à des ASIC? (eg CLIC/CRIC pour SNAP)



Karcher et al., SDW 2005

saclay

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Autres caméra grands champs en développement

- dapnia MMT/Megacam: 36 CCDs e2v 42-90 2Kx4.5K, Novembre 2003
 - ESO/Omegacam: 32 CCDs e2v 42-80 2Kx4K, 2007?
 - LAMOST: 32 CCDs e2v 4Kx4K, 2008?
 - WIYN/ODI: 64 OTA 4Kx4K OTCCDs, 2009?
- DES: 62 CCDs LBNL 2Kx4K, 2009?
 - DCT: 40 CCDs e2v 44-82 2Kx4K, 2010?
 - Pan-STARRS: 4x64 OTA 4Kx4K OTCCDs 2007-2010?
 - Subaru/HyperSuprimeCam: 170 CCDs 2Kx4K Hamamatsu, 2011?
 - LSST: 200 détecteurs 4Kx4K CCDs (e2v?) (+CMOS hybrides?), 2013?



© MMT/B. McLeod





Plan focal LSST

saclay

dapnia
 Besoin dérivé de la science: 3 10⁹ pixels à lire en 2s avec un bruit de 6e⁻ rms...

- Bruit $6e^{-} \Rightarrow$ cadence de lecture max ~500kHz
 - Temps de lecture $2s \Rightarrow 1$ Mpixels par sortie
- Taille de la mosaïque 3 10^9 pixels \Rightarrow 3000 sorties
- ⇒ Brique de base: 1 CCD 4Kx4K organisé en 8 « sous » CCDs 4000x500 à 2 sorties chacun
- \Rightarrow 200 CCDs pour une mosaïque de 3 10⁹ pixels et 3200 sorties



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007 102

Caméras grand champ spatiales

dapnia • Contraintes encore plus grandes que pour un CCD spatial:

- Puissance électrique pour piloter des dizaines de détecteurs
- Masse et volume de l'instrument
- Le moins possible de mécanique (obturateur, changement de filtres)
- Quantité de mémoire embarquée (stockage des images)
- Débit de télémétrie (réception des données à terre)
- NASA/Kepler: 42 CCDs e2v 2Kx1K, 2008
- DoE/SNAP: 36 CCDs LBNL 3.5Kx3.5K, 2014?
- ESA/DUNE: 36 CCDs e2v 4Kx4K, 2017?
- ESA/Gaia: 170 CCDs e2v 4500x1966, 2011?

DoE/SNAP

- dapnia Champ de vue 0.7 deg²
 - 36 CCDs custom LBNL/DALSA (3.5Kx3.5K pixels 10.5µmx10.5µm)
 - CCD épais (200 300 µm), back side illuminated, high resistivity, full
 depletion, full frame



ESA/DUNE

- dapnia Champ de vue 0.5 deg²
 - 36 CCDs e2v CCD203-82 (4Kx4K pixels 12µmx12µm)
 - CCD aminci back side illuminated, high resistivity, deep depletion, full
 frame, TDI

saclay





© e2v technologies

ESA/Gaia

- dapnia Champ de vue 0.6 deg²
 - 170 CCDs custom e2v (dont 110 4500x1966 pixels 10µmx30µm)
 - CCD aminci back side illuminated, full frame, TDI





saclay

Photos

La caméra MegaCam

dapnia

œ




L'archipel d'Hawaii

dapnia



Atlas of Hawaii, University of Hawaii Press, 1983

Le sommet du Mauna Kea





© R. Wainscoat, 1998

Les 2 télescopes Keck





© R. Wainscoat, 1998

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007 111

Le Mauna Kea sous la neige

dapnia

œ

saclay



© CEA-DAPNIA

Préparation de la caméra MegaCam





© CEA-DAPNIA

Installation au foyer primaire

dapnia

œ

saclay



© CEA-DAPNIA

Un peu d'acrobatie





© CEA-DAPNIA

MegaCam au foyer primaire du télescope CFHT



©2004 Canada-France-Hawaii Telescope

La nébuleuse de la Rosette

dapnia





©2003 Canada-France-Hawaii Telescope

Les 2 amas d'étoiles M35 et NGC2158

dapnia

œ



Le cœur de l'amas d'étoiles M35



saclay



©2003 Canada-France-Hawaii Telescope

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007 119

Une sous-image 8'x8' du champ profond D1 du CFHTLS

dapnia

œ

saclay



©2004 Canada-France-Hawaii Telescope

16 sous-images 90"x90" du champ D1 du CFHTLS

dapnia

œ



©2004 Canada-France-Hawaii Telescope

Les télescopes vus de la plage...



Mai-tai et macadamia nuts

dapnia



© 2005 Mauna Loa Macadamia Nut Corporation

Poissons hawaïens



Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

Pêche au gros à Hawaii

dapnia



saclay



© 2006, Chupu Charters Inc.

Ecole IN2P3 du détecteur à la mesure

13-21 Juin 2007 125

Pêche au très gros à Hawaii





© Hawaii Fishing News 2002

© 2001-2006 Black Bart International, LLC